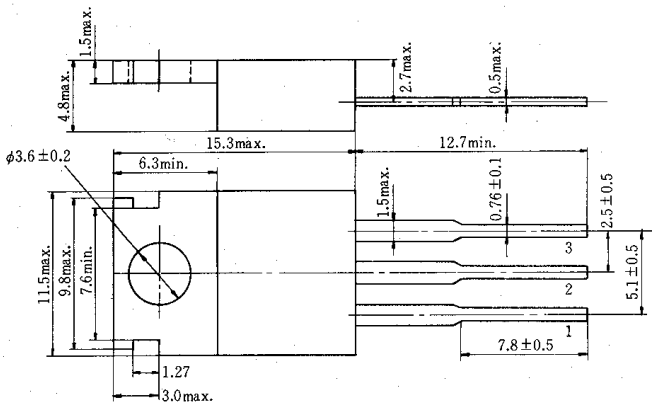
2SA755

シリコン PNP 三重拡散形
低周波電力増幅用
2SC1419とコンプリメンタリペア

SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED
LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
Complementary pair with 2SC1419



1. ベース：Base
2. コレクタ：Collector
(フランジ) (Flange)
3. エミッタ：Emitter
(Dimensions in mm)

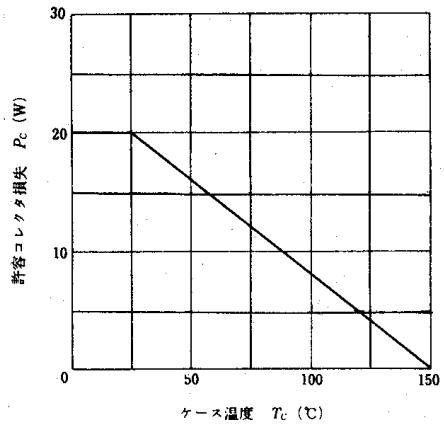
(JEDEC TO-220AB)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

項目	Symbol	2SA755	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	−50	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	−50	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	−4	V
コレクタ電流	I_C	−2	A
許容コレクタ損失	P_C *	20	W
接合部温度	T_j	150	℃
保存温度	T_{stg}	−55～+150	℃

* T_C=25℃における許容値
* Value at T_C=25℃

許容コレクタ損失のケース温度による変化
MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	I_C=−5mA, I_E=0	−50	−	−	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	I_C=−50mA, R_{BE}=∞	−50	−	−	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	I_E=−5mA, I_C=0	−4	−	−	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	V_{CB}=−20V, I_E=0	−	−	−100	μA
直流電流増幅率	h_{FE}*	V_{CE}=−4V, I_C=−1A	35	−	200	
直流電流増幅率	h_{FE}	V_{CE}=−4V, I_C=−0.1A	35	−	−	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=−1.5A, I_B=−0.15A	−	−	−1.3	V
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	V_{CE}=−4V, I_C=−1A	−	−0.9	−1.5	V
2次破壊電流	I_M**	V_{CE}=−30V, f=50Hz (half wave)	−2.0	−	−	A
利得帯域幅積	f_T	V_{CE}=−4V, I_C=−0.5A	−	50	−	MHz

*2SA755はh_{FE}の値により下記のように3区分し，現品に表示してあります。
*The 2AS755 is grouped by h_{FE} as follows.

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
35～70	60～120	100～200

** 2次破壊時における電流で定義される。
** I_M is defined as the current at which second breakdown occurs.